

InGaAs Tap-PD Chip For EDFA $\phi 80\mu\text{m}$



产品描述

用于 EDFA 的 InGaAs Tap-PD 芯片

产品特点

高线性度； $\phi 80\mu\text{m}$ 有效面积；高响应度；顶照式平面结构

应用领域

EDFA 用 Tap-PD | 移动通信系统



详细参数



规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.95		A/W	$\lambda=1310-1550\text{nm}$
暗电流	I_D		0.05	0.2	nA	$V_R=-5\text{V}, T_c=25^\circ\text{C}$
			1.2	2.0	pF	$V_R=-5\text{V}, T_c=75^\circ\text{C}$
二阶失真	CSO		-60		dBc	$V_R=-12\text{V}$
三阶失真	CTB		-70		dBc	$V_R=-12\text{V}$
带宽	Bw		1.0		GHz	3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		80		um	